

Перв. примен. МГТУ.4644.15.001	Справ. №	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
			Конденсаторы						
		С1	Чип-конденсатор керамический С1005Х5R1Е104КТ; 0402; 0,1 мкФ ± 10%; 25 В; Х5R; (Китай)	1					
		С2	Чип-конденсатор керамический С105А105КР5NNNC; 0402; 1 мкФ ± 10%; 10 В; Х5R; (Китай)	1					
		С3	Чип-конденсатор керамический С105А475КР5NRNC; 0402; 4,7 мкФ ± 10%; 10 В; Х5R; (Китай)	1					
		С4	Чип-конденсатор керамический С1005Х5R1Е104КТ; 0402; 0,1 мкФ ± 10%; 25 В; Х5R; (Китай)	1					
		С5	Чип-конденсатор керамический С105А105КР5NNNC; 0402; 1 мкФ ± 10%; 10 В; Х5R; (Китай)	1					
		С6	Чип-конденсатор керамический С1005Х5R1Е104КТ; 0402; 0,1 мкФ ± 10%; 25 В; Х5R; (Китай)	1					
		С7, С8	Чип-конденсатор керамический 0402N6R2С50; 0402; 6,2 пФ ± 0,25 пФ; 50 В; NР0; (Китай)	2					
		С9...С12	Чип-конденсатор керамический С1005Х5R1Е104КТ; 0402; 0,1 мкФ ± 10%; 25 В; Х5R; (Китай)	4					
		С13	Чип-конденсатор керамический С105А105КР5NNNC; 0402; 1 мкФ ± 10%; 10 В; Х5R; (Китай)	1					
		С14...С16	Чип-конденсатор керамический С1005Х5R1Е104КТ; 0402; 0,1 мкФ ± 10%; 25 В; Х5R; (Китай)	3					
		С17	Чип-конденсатор керамический 0402N470J50; 0402; 47 пФ ± 5%; 50 В; NР0; (Китай)	1					
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам инв. №							
Подп. и дата	Инв. № подл.								
		МГТУ.4644.15.001 ПЭЗ							
Инв. № подл.	Разраб.	Уваровский			Плата печатная	Лит.	Лист	Листов	
	Пров.	Жаркова					1	4	
	Н. контр.					Перечень элементов	МГТУ им. Н. Э. Баумана		
	Утв.								

		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		С18, С19	Чип-конденсатор керамический 0402N6R2C50; 0402; 6,2 пФ ± 0,25 пФ; 50 В; NPO; (Китай)	2	
		С20	Чип-конденсатор керамический С1005Х5R1Е104КТ; 0402; 0,1 мкФ ± 10%; 25 В; Х5R; (Китай)	1	
		С21	Чип-конденсатор керамический 0402N4 70J50; 0402; 4,7 пФ ± 5%; 50 В; NPO; (Китай)	1	
		С22	Чип-конденсатор керамический С1005Х5R1Е104КТ; 0402; 0,1 мкФ ± 10%; 25 В; Х5R; (Китай)	1	
		С23	Чип-конденсатор керамический 0402N2R2C50; 0402; 2,2 пФ ± 0,25 пФ; 50 В; NPO; (Китай)	1	
		С24	Чип-конденсатор керамический 0402N6R8C50; 0402; 6,8 пФ ± 0,25 пФ; 50 В; NPO; (Китай)	1	
		С25	Чип-конденсатор керамический 0402N150J50; 0402; 15 пФ ± 5%; 50 В; NPO; (Китай)	1	
Подп. и дата		С26	Чип-конденсатор керамический 0402N120J50; 0402; 12 пФ ± 5%; 50 В; NPO; (Китай)	1	
		С27	Чип-конденсатор керамический 0402N6R8C50; 0402; 6,8 пФ ± 0,25 пФ; 50 В; NPO; (Китай)	1	
Инв. № докл.		С28	Чип-конденсатор керамический 0402В103К50; 0402; 0,01 мкФ ± 10%; 50 В; Х7R; (Китай)	1	
		С29, С30	Чип-конденсатор керамический 0402N4 70J50; 0402; 4,7 пФ ± 5%; 50 В; NPO; (Китай)	2	
Взам. инв. №		С31, С32	Чип-конденсатор керамический С1005Х5R1Е104КТ; 0402; 0,1 мкФ ± 10%; 25 В; Х5R; (Китай)	2	
Подп. и дата			Микросхемы		
		DA1	Микросхема LDL1117S33R; STMicroelectronics (США)	1	
Инв. № подл.					
				МГТУ.4644.15.001 ПЗЗ	
				2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		DD1	Микросхема STM32L151C6T6;		
			STMicroelectronics (CША)	1	
		DD2	Микросхема CP2102N; Silicon Labs (CША)	1	
		DD3	Микросхема 24LC512-I/SM;		
			Microchip Technology (CША)	1	
		DD4	Микросхема SX1276IML TRT;		
			Semtech Corporation (CША)	1	
		DD5	Микросхема ADM3485ARZ; Analog Devices Inc. (CША)	1	
		DD6	Микросхема SN65HVD232; Texas Instruments (CША)	1	
			Катушки индуктивности		
		L1	Чип-индуктивность TL160808 100K; 0603;		
			10 мкГн ± 10%; 3 мА; (Китай)	1	
		L2	Чип-индуктивность TF160808 4N7S; 0603;		
			4,7 нГн ± 0,3 нГн; 1000 мА; (Китай)	1	
		L3, L4	Чип-индуктивность TF160808 22NK; 0603;		
			22 нГн ± 10%; 600 мА; (Китай)	2	
		L5, L6	Чип-индуктивность TF160808 18NK; 0603;		
			18 нГн ± 10%; 600 мА; (Китай)	2	
			Резисторы		
		R1	Чип-резистор; 0402; 10 кОм ± 5%; 0,1 Вт; (Китай)	1	
		R2	Чип-резистор; 0402; 36 Ом ± 5%; 0,1 Вт; (Китай)	1	
		R3, R4	Чип-резистор; 0402; 5,1 Ом ± 5%; 0,1 Вт; (Китай)	2	
		R5	Чип-резистор; 0402; 10 кОм ± 5%; 0,1 Вт; (Китай)	1	
		R6	Чип-резистор; 0402; 4,7 кОм ± 5%; 0,1 Вт; (Китай)	1	
		R7	Чип-резистор; 0402; 120 Ом ± 5%; 0,1 Вт; (Китай)	1	
		R8, R9	Чип-резистор; 0402; 5,1 Ом ± 5%; 0,1 Вт; (Китай)	2	
		R10	Чип-резистор; 0402; 4,7 кОм ± 5%; 0,1 Вт; (Китай)	1	

<i>Поз. обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
R11	Чип-резистор; 0402; 120 Ом ± 5%; 0,1 Вт; (Kumaū)	1	
R12, R13	Чип-резистор; 0402; 5,1 Ом ± 5%; 0,1 Вт; (Kumaū)	2	
R14, R15	Чип-резистор; 0402; 1 кОм ± 5%; 0,1 Вт; (Kumaū)	2	
	<u>Диоды</u>		
VD1	Чип LED-светодиод BL-HJD36A-AV (HUB36A); 0603; (Kumaū)	1	
VD2	Чип LED-светодиод BL-HG636D; 0603; (Kumaū)	1	
VD3, VD4	Чип LED-светодиод BL-HB536A; 0603; (Kumaū)	2	
VD5	Чип LED-светодиод BL-HG636D; 0603; (Kumaū)	1	
VD6	Чип LED-светодиод BL-HB536A; 0603; (Kumaū)	1	
VD7	Чип LED-светодиод BL-HG636D; 0603; (Kumaū)	1	
	<u>Разъемы</u>		
X1	Вилка прямая DS-1021-1x4; PLS-4; 2,54 мм; Ningbo Connfly Electronic (Kumaū)	1	
X2	Разъем micro-USB ZX62-B-5PA; Hirose Electric (Япония)	1	
X3, X4	Клеммник трехконтактный DG350-3.5-03P-14; Degson Electronics (Kumaū)	2	
	<u>Прочее</u>		
A1	Чип-антенна керамическая ACAG1204-433-T; Abracorp (США)	1	
SB1	DIP-переключатель DS1040-01RT; Ningbo Connfly Electronic (Kumaū)	1	
SB2, SB3	Кнопка тактовая SMD; 6х6х5 мм; Switronic Industrial (Kumaū)	2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МГТУ.4644.15.001 ПЭЗ

Лист

4

Копировал:

